

# 半导体学报

第4卷 第6期 1983年11月

## 目 录

- 非晶态硅的带隙态密度.....夏建白 (515)
- 原生掺 Si 砷化镓单晶微缺陷的研究 .....  
.....何宏家 曹福年 范缙文 白玉珂 费雪英 王凤莲 褚一鸣 (526)
- 深中心行为图形表示方法的探讨.....  
.....阮圣央 张砚华 郑秉茹 杨锡权 吉秀江 (531)
- 离子注入在  $\text{SiO}_2$  中引入的陷阱中心 ..... 周光能 郑有焯 吴汝麟 (540)
- 用连续调谐  $\text{CO}_2$  激光器研究 InSb 自由载流子法拉第旋转 ..... 邢启江  
 陈辰嘉 王学忠 史守旭 朱印康 王威礼 曹树石 刘继周 刘彩霞 (549)
- a-Si:H 材料中的场致电导漂移 ..... 熊绍珍 孙钟林 (555)
- 半绝缘 InP 注硅的无包封退火...乔 塘 卢建国 罗潮渭 邵永富 王渭源 (560)
- 用拼版法研制大规模集成电路的掩膜版.....林 雨 (565)
- 考虑非局域势的 Si 能带的紧束缚计算.....王永良 顾宗权 (574)

## 研 究 简 报

- 高浓度注砷硅的红外瞬态辐照退火.....侯东彦 钱佩信 李志坚 (579)
- 射频溅射 a-Si:H 样品的光诱导光学吸收的变化 .....  
.....章佩娴 谭翠玲 朱琼瑞 彭少麒 (586)
- a-Si:(H,Cl) 薄膜的 XPS 和 UPS 研究.....  
.....邢益荣 钟战天 沈光地 孔光临 廖显伯 杨喜荣 (590)
- GD a-Si:(Cl, H) 薄膜的 ESR 研究.....  
.....廖显伯 杨喜荣 刘昌灵 孔光临 侯 贵 徐广智 (593)
- 在离子注入硅激光退火时引入缺陷.....鲍希茂 黄信凡 郭 禾 张 梅 (596)
- 离子注入氮化硅隔离的 CMOS 器件.....  
.....刘忠立 伏·车慈曼 依·罗伯特 格·启姆 (601)
- 又一种具有特殊界面效应的稀有金属杂质铈.....李思渊 张同军 李寿嵩 (606)